

Samsung MZ-VAP1T0 1 TB M.2 PCI Express 5.0 NVMe V-NAND TLC

Ref.: HD34651215 P/N: MZ-VAP1T0BW



Detalle del producto

- 1 TB M.2 PCI Express 5.0
- Velocidad de lectura: 14700 MB/s 1850000 IOPS
- Velocidad de escritura: 13300 MB/s 2600000 IOPS
- V-NAND TLC NVMe 2.0
- Encriptación de hardware 256-bit AES
- Soporte S.M.A.R.T. Soporte TRIM
- Componente para: PC/Consola de videojuegos

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#) 1 TB M.2 PCI Express 5.0 Velocidad de lectura: 14700 MB/s 1850000 IOPS Velocidad de escritura: 13300 MB/s 2600000 IOPSV-NAND TLC NVMe 2.0 Encriptación de hardware 256-bit AES Soporte S.M.A.R.T. Soporte TRIM Componente para: PC/Consola de videojuegos

SDD, capacidad 1 TB

Factor de forma de disco SSD M.2

Interfaz PCI Express 5.0

NVMeSi

Versión NVMe 2.0

Tipo de memoria V-NAND TLC

Componente para PC/Consola de videojuegos

Encriptación de hardware Si

Algoritmos de seguridad soportados 256-bit AES

Tamaño de la unidad SSD M.2 2280 (22 x 80 mm)

Velocidad de lectura 14700 MB/s

Velocidad de escritura 13300 MB/s

Lectura aleatoria (4KB) 1850000 IOPS

Escritura aleatoria (4KB) 2600000 IOPS

Carriles datos de interfaz PCI Express x4

Función DevSleep Si

Soporte TRIM Si

Soporte S.M.A.R.T. Si

Voltaje de operación 3,3 V

Tiempo medio entre fallos 1500000 h

Consumo de energía (lectura) 7,6 W

Consumo de energía (escritura)7,2 W
Consumo eléctrico promedio (lectura)7,6 W
Consumo eléctrico promedio (escritura)7,2 W
Intervalo de temperatura operativa0 - 70 °C
Consumo de energía (espera)0,004 W
Ancho80,2 mm
Consumo de potencia DevSlp (modo sueño)3,3 mW
Profundidad2,38 mm
Altura80,2 mm
Golpes en funcionamiento1500 G
Peso9 g
Periodo de garantía5 año(s)
Tipo de embalajeCaja

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*